

トランジスタ

2SD1091

# 2SD1091

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形ダーリントン / Si NPN Triple Diffused Planar Darlington

電力増幅用 / Power Amplifier

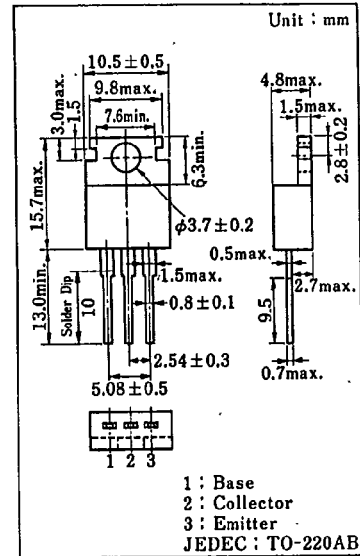
### ■ 特徴 / Features

- 直流電流増幅率  $h_{FE}$  が高い。 / High  $h_{FE}$
- コレクタ・ベース電圧  $V_{CBO}$  が高い。 / High  $V_{CBO}$

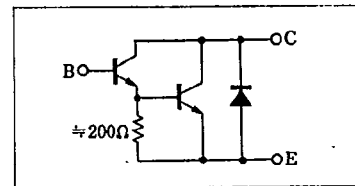
### ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	170	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CER}^*$	170	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	6	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	8	A
コレクタ電流	$I_C$	4	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	40	W
接合部温度	$T_J$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

\*  $R_{BE} = 4.7\text{ k}\Omega$



内部接続図 / Connection Diagram



### ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 170\text{ V}, I_E = 0$			10	$\mu\text{A}$
	$I_{CER}$	$V_{CE} = 170\text{ V}, R_{BE} = 4.7\text{ k}\Omega$			10	$\mu\text{A}$
エミッタしや断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 6\text{ V}, I_C = 0$			2	mA
直流電流増幅率	$h_{FE}^{*1}$	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	2000		12000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 3\text{ A}, I_B = 30\text{ mA}$			1.7	V
コレクタしや断電流	$I_{CER}^{*2}$	$V_{CE} = 150\text{ V}, R_{BE} = 4.7\text{ k}\Omega$			10	$\mu\text{A}$

<sup>\*2</sup>  $T_c = 100^\circ\text{C}$

### <sup>\*1</sup> $h_{FE}$ ランク分類 / $h_{FE}$ Classifications

Class	Q	P
$h_{FE}$	2000 ~ 6000	4000 ~ 12000

T-33-29

